

GD175

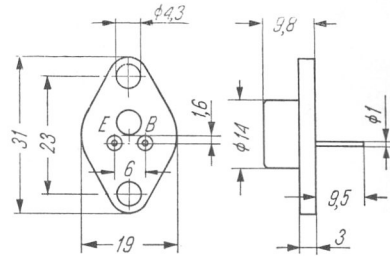
Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy *p-n-p* w obudowie metalowej, ciężar około 7,5 G

Zastosowanie: układy przełączające do 48 V, wzmacniacze mocy m.cz., parowane do układów przeciwobnych o napięciu szczytowym do 50 V

Typy podobne: 4NU72 (Tes), AD152 (Siem), AD1202 (Tung), OD603/50 (Tel)



Rys. 1-695. GD175

Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max		
$-I_{CBO}$		20	50	μA	przy $-U_{CB} = 6 V$
$-I_{CES}$		300	1000	μA	przy $-U_{CE} = 48 V$
$-I_{EBO}$		60	100	μA	przy $-U_{EB} = 10 V$
$-U_{CEsat}$		0,3	0,6	V	przy $-I_B = 0,5 A, -I_C = 3 A$
$-U_{BE}$		0,35	0,5	V	przy $-U_{CE} = 6 V, -I_C = 0,2 A$
$-U_{BE}$		0,75	1,0	V	przy $-U_{CE} = 2 V, -I_C = 1,5 A$
f_T	250			kHz	przy $-U_{CE} = 6 V, -I_C = 0,1 A$
h_{21E} (A)	18		35		przy $-U_{CE} = 6 V,$ $-I_C = 1,5 A$
(B)	28		56		
(C)	45		90		
h_{21E}	30				przy $-U_{CE} = 6 V, -I_C = 1,5 A$
$\frac{h_{21E}(1,5)}{h_{21E}(0,5)}$	0,5				przy $-U_{CE} = 2 V, -I_C = 1,5 A,$ $-I_C = 0,2 A$
$\frac{I_{B1}^{2)}}{I_{B2}}$	0,833		1,2		przy $I_{B1}: -U_{CE} = 6 V, -I_C = 0,2 A$ $I_{B2}: -U_{CE} = 2 V, -I_C = 3 A$
$\frac{U_{BE1}^{2)}}{U_{BE2}}$	0,833		1,2		przy $-U_{CE} = 2 V, -I_C = 3 A$

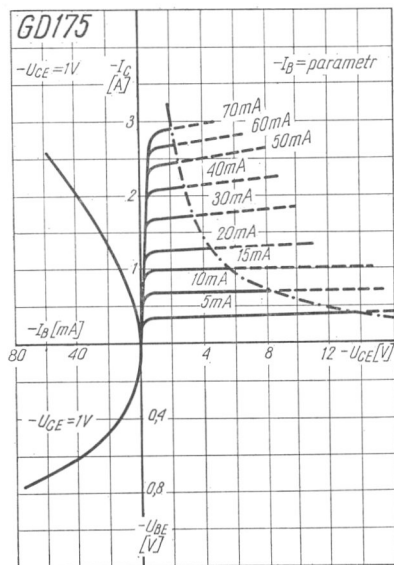
Wartości graniczne

$-U_{CBO} \max$	50	V	$-I_B \max$	0,6	A
$-U_{CER} \max$	48 ³⁾	V	$I_E \max$	3,6	A
$-U_{CES} \max$	50	V	$t_j \max$	+85	$^{\circ}C$
$-U_{EBO} \max$	10	V	t_{amb}	-25 ÷ +65	$^{\circ}C$
$P_{tot} \max$	5,3	W	$R_{thj-a} \max$	7,5	$^{\circ}C/W$
$-I_C \max$	3,0	A			

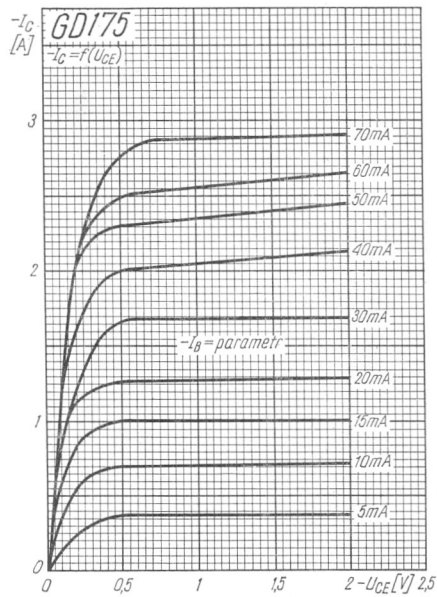
¹⁾ $t_{amb} = 25^{\circ}C (-5^{\circ}C)$

²⁾ warunek dobierania parami (2 × GD175)

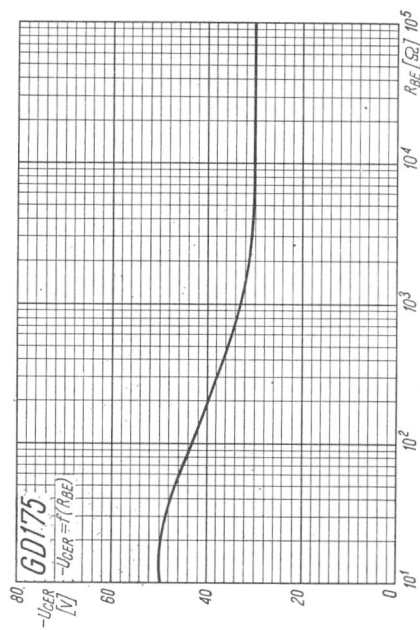
³⁾ $R_{BE} = 50 \Omega$



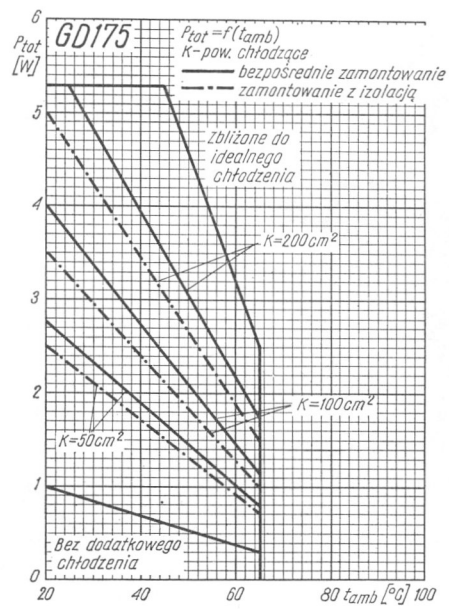
Rys. 1-696. Charakterystyki statyczne



Rys. 1-697. Charakterystyki wyjściowe



Rys. 1-698. Zależność napięcia kolektora od rezystancji R_{BE}



Rys. 1-699. Zależność mocy strat od temperatury otoczenia

